

平成 29 年 6 月 5 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 153 回研究会 開催通知

日時： 2017 年 7 月 21 日 (金) 12:30～

会場： 明治大学駿河台キャンパス 大学会館 8 階 第 3&4 会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL: 03-3296-4545 明治大学総合案内)

交通： JR 中央線・総武線，東京メトロ丸の内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分

都営地下鉄三田線・新宿線，東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ：最先端ゲッターリング技術の研究開発動向

世話人：末岡 浩治 (岡山県立大学)，小椋 厚志 (明治大学)，泉妻 宏治 (グローバルウェーハズ・ジャパン)，佐俣 秀一 (SUMCO)

プログラム：

- | | | | | |
|------|-------------|--|--------------------|--------------|
| (1) | 12:30-12:35 | 開会の挨拶 | 明治大学 | 田島 道夫 |
| (2) | 12:35-12:40 | はじめに | 岡山県立大学 | 末岡 浩治 |
| (3) | 12:40-13:20 | イントロインシク・ゲッターリング能力を付与した各種 IG-Si ウェーハ製品の開発経緯 | SUMCO | 宝来 正隆 |
| (4) | 13:20-14:00 | Si 基板の酸素析出物またはイオン注入欠陥によりゲッターリングされた金属の深さ方向分布 | ソニーセミコンダクタソリューションズ | 嵯峨 幸一郎，大野カール |
| (5) | 14:00-14:40 | デバイスエンジニアが注目するゲッターリング技術動向 | マイクロンメモリジャパン | 小此木 堅祐 |
| | 14:40-14:55 | 休憩 | | |
| (6) | 14:55-15:35 | 超高温 RTP による窒素ドーピング Cz-Si ウェーハの酸素析出挙動 | グローバルウェーハズ・ジャパン | 前田 進 |
| (7) | 15:35-16:15 | 多元素・分子クラスターイオン注入による近接ゲッターリング技術 | SUMCO | 栗田 一成 |
| (8) | 16:15-16:55 | 近接および超近接ゲッターリング技術を用いた CMOS イメージセンサのホワイトスポット低減 | ルネサス | 山口 直 |
| (9) | 16:55-17:35 | 新しい材料計算”箱庭法”の紹介～シリコン材料の開発現場における第一原理計算の活用を目指して～ | グローバルウェーハズ・ジャパン | 神山 栄治 |
| (10) | 17:35-17:40 | おわりに | グローバルウェーハズ・ジャパン | 泉妻 宏治 |
| | 18:00-20:00 | 意見交換会 (於) リバティータワー23 階 宮城浩三ホール | | |